

СОДЕРЖАНИЕ

Том 46, номер 3, 2017

Сообщение 163

РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭЛЕМЕНТАХ И СИСТЕМАХ

Анализ устойчивости МИС преобразователя сигнала СВЧ диапазона к воздействию специальных факторов

К. А. Кагирина, Ю. В. Федоров, Д. В. Лаврухин, С. А. Гамкредидзе, Д. Л. Гнатюк, А. В. Зувев, О. А. Рубан, Д. В. Громов 164

Методы функционально-логического моделирования радиационных отказов электронных систем, основанные на модели нечеткого цифрового автомата

В. М. Барбашов, О. А. Калашников 170

Моделирование воздействия ТЗЧ на УНТ-нано датчик методом молекулярной динамики

А. В. Согоян, Д. В. Бойченко, А. В. Демидова 177

Особенности воздействия электромагнитных излучений на интегральные схемы

П. К. Скоробогатов, О. А. Герасимчук, К. А. Епифанцев, В. А. Телец 181

Функциональный контроль процессоров цифровой обработки сигналов при радиационных исследованиях

В. А. Марфин, П. В. Некрасов, О. А. Калашников, А. Ю. Никифоров 187

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Резистивные переключения в мезоскопических гетероструктурах на основе эпитаксиальных пленок $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4-y}$

Н. А. Тулина, А. А. Иванов, А. Н. Россоленко, И. М. Шмытько, А. М. Ионов, Р. Н. Можиль, И. Ю. Борисенко 197

Исследование переходных процессов в $p-i-n$ фотодетекторе с использованием нестационарной физико-топологической модели

Е. А. Рындин, И. В. Писаренко 203

ТЕХНОЛОГИИ ВЕОЛ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Графеновый гибкий сенсорный экран с интегрированным аналого-цифровым преобразователем

А. И. Власов, Д. С. Терентьев, В. А. Шахнов 210

Разделение высокотвердых полупроводниковых пластин сапфира на монолитные интегральные схемы методом лазерного управляемого термораскалывания

Н. В. Шаврук, С. В. Редькин, А. А. Трофимов, Н. Е. Иванова, А. С. Скрипниченко, В. С. Кондратенко, В. В. Стыран 219

ПРИБОРЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Силовые коммутационные транзисторы на основе эпитаксиальных гетероструктур нитрида галлия

Е. В. Ерофеев, И. В. Федин, Ю. Н. Юрьев 224

КИНЕТИКА ПЛАЗМЫ

Влияние добавок Ag и He на кинетику травления GaAs в плазме CF_2Cl_2

С. А. Пивоваренок

231

СХЕМОТЕХНИКА

Схемотехническая модель инжекционных функционально интегрированных лазеров-модуляторов

Б. Г. Коноплев, Е. А. Рындин, М. А. Денисенко

236

Сдано в набор 10.01.2017 г.	Подписано к печати 13.03.2017 г.	Дата выхода в свет 23.05.2017 г.	Формат $60 \times 88^{1/8}$
Цифровая печать	Усл. печ. л. 10.5	Усл. кр.-отт. 1.0 тыс.	Уч.-изд. л. 10.5
	Тираж 92 экз.	Зак. 280	Бум. л. 5.25
		Цена свободная	

Учредители: Российская академия наук, Физико-технологический институт РАН

Издатель: Российская академия наук. Издательство "Наука", 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
 Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"
 Отпечатано в типографии "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6